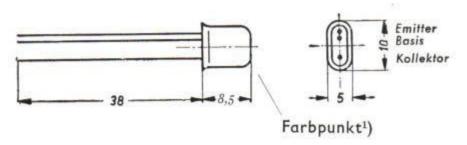
Ausgabe: November 1957

OC 816 p-n-p-Flächentransistor In Vorbereitung



Verwendung:

Der Transistor OC 816 ist geeignet für Endstufen kleiner Leistung, für Vorverstärkerstufen und Treiberstufen für Gegentaktendverstärker, z. B. für 2 OC 821.

Kennwerte:

Emitterschaltung gemessen bei

$$\theta \alpha = 25^{\circ} \text{ C}; \quad -\text{U}_{\text{CE}} = 6 \text{ V} \quad -\text{J}_{\text{C}} = 2 \text{ mA}; \quad f = 1 \text{ kHz}$$
Kurzschluß-Eingangswiderstand $h'_{11} = 0,4 \cdots 2 \text{ k}\Omega$
Leerlauf-Spannungsrückwirkung $h'_{12} = 4 \cdots 25 \cdot 10^{-4}$
Kurzschluß-Stromverstärkung $h'_{21} = 20 \cdots 100^{1}$)
Leerlauf-Ausgangsleitwert $h'_{22} = 20 \cdots 150 \text{ }\mu\text{S}$
Leistungsverstärkung $G' = 32 \cdots 45 \text{ }d\text{B}$
(bei $-\text{U}_{\text{CE}} = 6 \text{ V}; -\text{J}_{\text{C}} = 1 \text{ mA}; \quad R_{\text{L}} = 50 \text{ k}\Omega$)
Rauschfaktor $F < 25 \text{ }d\text{B}$
(bei $-\text{U}_{\text{CE}} = 1 \text{ V}; -\text{J}_{\text{C}} = 1 \text{ mA}; \quad R_{\text{g}} = 500 \Omega, \quad f = 1 \text{ kHz}$)
Grenzfrequenz $f \alpha > 300 \text{ kHz}$
(gemessen in Basisschaltung bei $-\text{U}_{\text{CB}} = 6 \text{ V}; -\text{J}_{\text{C}} = 2 \text{ mA}$)

1) s. Seite 2

Ausgabe: November 1957

OC 816 p-n-p-Flächentransistor In Vorbereitung

Maximalwerte:

Kollektorreststrom

bei — $U_{CB}=6\ V\ J_E=0$:	— Jco	≤ 20	μA
bei – $U_{CE} = 6 V J_B = 0$:	— J'co	≤ 400	μA
Kollektorrestspannung			
bei $-J_c = 10 \text{mA}$	- UR	≤ 0,3	V
Kollektorspannung	- U _{CEmax}	= 10	V
Kollektorspitzenspannung	- UCEsp	= 15	V
Kollektorstrom	— J _{cmax}	= 20	mA
Kollektorspitzenstrom	— J _{csp}	= 50	mA
Verlustleistung	N_{vmax}	= 50	mW^2)
Sperrschichttemperatur	$\theta_{j_{max}}$	= 65°	С
Wärmewiderstand	ж	$= 0.4^{\circ} \text{C/mW}$	
Temperaturbereich	A cc	= -40.	+ 65° C

1) Farbkennzeichnung

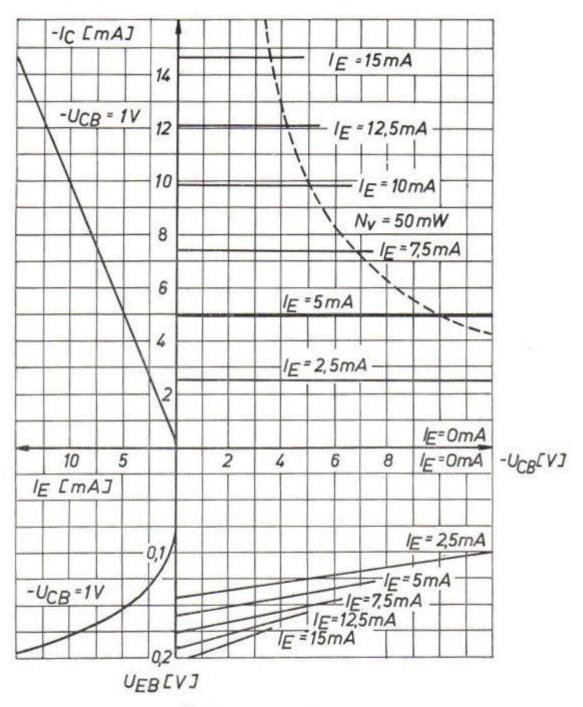
²) Gesamte im Transistor auftretende Verlustleistung (Emitter- und Kollektorverlustleistung).

Sie ist abhängig von der Umgebungstemperatur.

s. Bl. OC 816 Seite 5.

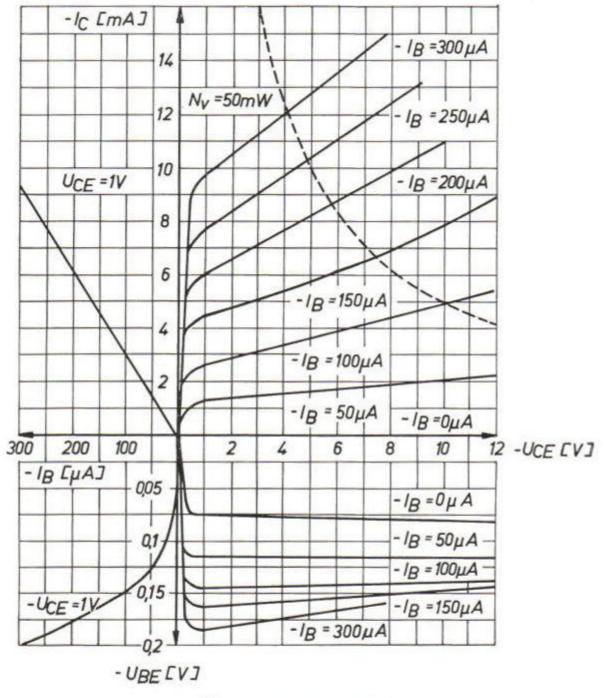
Ausgabe: November 1957

OC 816
p-n-p-Flächentransistor
In Vorbereitung
Kennlinienfeld in Basisschaltung



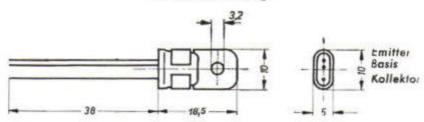
Ausgabe: November 1957

OC 816
p-n-p-Flächentransistor
In Vorbeitung
Kennlinienfeld in Emitterschaltung



Ausgabe: November 1957





Verwendung:

Der Transistor OC 820 ist geeignet für Endstufen mittlerer Leistung, in Treiberstufen für Gegentaktendstufen, sowie als Oszillator für mittlere Leistungen.

Kennwerte:

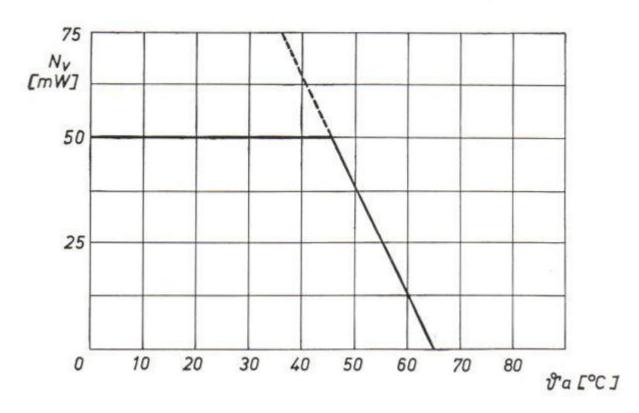
Emitterschaltung; gemessen bei $\vartheta \alpha = 25^{\circ}$ C

Basisstrom

Ausgabe: November 1957

OC 815; OC 816 p-n-p-Flächentransistoren In Vorbereitung

Abhängigkeit der Verlustleistung N_v von der Umgebungstemperatur ϑ_α

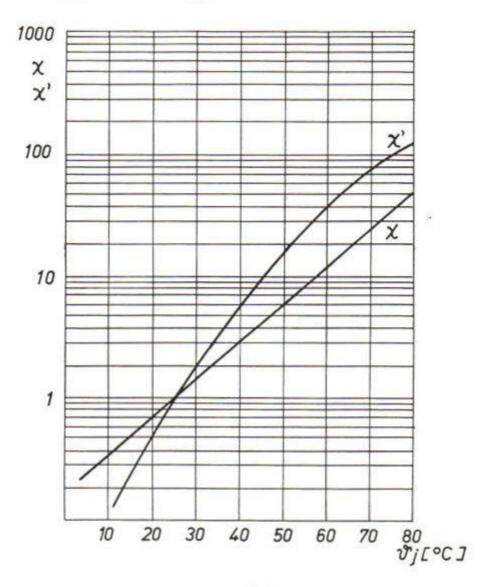


$$\begin{split} N_v &= N_E + N_C = 50 \text{ mW maximal} \\ \vartheta_j &= 65^\circ \text{ C} \\ \varkappa &= \frac{\vartheta_j - \vartheta_\alpha}{N_v} = 0.4 \frac{{}^\circ \text{ C}}{\text{mW}} = \text{konst.} \end{split}$$

Ausgabe: November 1957

OC 815; OC 816 p-n-p-Flächentransistoren In Vorbereitung

Temperaturabhängigkeit des Kollektorreststromes



$$\chi = \frac{(J_{co})_{\vartheta_{j}}}{(J_{co})_{\vartheta_{j}} = 25^{\circ} C}$$

$$\chi' = \frac{(J'_{co})_{\vartheta_{j}}}{(J'_{co})_{\vartheta_{j}} = 25^{\circ} C}$$